

بررسی نظری تأثیر فاصله چشمه تا زیرلایه بر لایه نشانی مس به روش تبخیر حرارتی

جواد على پور زردكوهي | فاطمه شريعتمدار طهراني * | مريم علياننژادي

دانشکده فیزیک، دانشگاه سمنان، سمنان

چکیده: لایههای نازک مس به طور گسترده در حسگرهای امنیتی، حسگرهای پزشکی، صفحات خورشیدی، لیزرهای قفل شده مد، درمان سرطان و کاربرد دارند. روش تبخیر حرارتی روش مناسبی برای ایجاد لایههای نازک مس است. فاصله بین چشمه مس و زیرلایه پارامتر مهمی است که تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراین، در این مقاله تأثیر این کمیت بر فرایند ایجاد لایه نازک مس با روش تبخیر حرارتی به صورت نظری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که فشار بخار مس بر سطح زیرلایه، نرخ لایهنشانی و ضخامت لایه نازک با افزایش این فاصله کاهش می ابد. در حالی که مقدار یکنواختی ضخامت لایه نازک با افزایش این فاصله بهبود می یابد. با افزایش فاصله از ست ۳ ترخ لایه نشانی از ۸/۵۷mm تا پینازک پهنای تابع ضخامت لایه از محمد تا افزایش می یابد. همچنین، تابع وابستگی پهنای ضخامت و نرخ لایهنشانی لایه نازک به فاصله چشمه تا سطح زیرلایه ارائه شده است تا فاصله مناسب با توجه به کاربرد لایه نازک انتخاب شود.

واژههای کلیدی: لایه نشانی، لایههای نازک مس، تبخیر حرارتی.

<u>f_tehrani@semnan.ac.ir</u>

۱– مقدمه

مس به دلیل ویژگیهای خاص و نیز ارزانی و فراوانی در پزشکی مور توجه خاص قرار دارد. نانوذرات اکسید مس با کمک عصاره-های متفاوت گیاه مانند Ficus religioss و Aalalha indica سنتز می شوند. به این روش سنتز سبز نانوذرات گفته می شود که به نظر می رسد روش قابل اعتماد، ساده ، غیر سمی و سازگار با محیط زیست است. این نانوذرات اثرات سمیت سلولی را با ایجاد آپوپتوز و افزایش تولید ROS در سلولهای سرطانی ریه انسان ملانوم پوست انسان میشوند [۲]. همچنین، اثر مهارکنندگی رشد سلولهای سرطان سینه انسان با استفاده از کورکومین با پوشش سلولهای سرطان مینه انسان با استفاده از کورکومین با پوشش برای درمان ملانوما و متاستاز تومورهای ریه موش نیز به کار

رفتهاند و ویژگی ضد توموری این نانوذرات به اثبات رسیده است. برای این منظور دوز ۲mg/kg به موش داده شد و پس از ۷ روز ارگانهای حیاتی موش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نانوذرات اکسید مس بدون کوچکترین سمیتی از اندامهای حیاتی بدن جدا میشوند [۴]. خطرات ناشی از استفاده از CONP ها^۱ جنبه مهمی است که برای استفاده ایمن و مؤثر از آنها باید مورد توجه قرار بگیرد. اگرچه مقالات کمی در رابطه با سمیت نانوذرات فلزی وجود دارد، اما ایجاد ویژگی سمیت توسط نانوذرات فلزی در بافت انسان گزارش شده است. به طور معمول سمیت نانوذرات فلزی به اندازه و بار سطحی آنها بستگی دارد. همچنین نتایج نشان داده است که که نانوذرات نسبت به

¹ Copper oxide nanoparticles تاریخ دریافت : ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ تاریخ پذیرش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

میکروصفحات دارای ویژگی سمیت بسیار بیشتری هستند [۵]. به تازگی، ساخت لایه های نازک حاوی مس با ویژگی ضدباکتریایی گزارش شده است[۶]. همچنین، ویژگی ضدقارچی لایههای نازک مس ارائه و پایداری آنها مورد بررسی قرار گرفته است [۷].

لایههای نازک مس در حسگرهای امنیتی، پزشکی و حسگرهایی که دما و پارامترهای حیاتی بدن را چک میکنند، مورد استفاده قرار میگیرند. ضخامت این لایههای نازک و مقدار یکنواختی آنها بسیار مهم است و باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد [۸]. افزون بر این، سرطان یکی از چالشهای مهمی است که جامعه انسانی با آن روبرو است. روشهای غیرتهاجمی درمان سرطان بر پایه درمان با لیزر و نانوذرات متفاوت توسعه یافتهاند. برای این منظور استفاده از نانوذرات و لیزرهای متفاوت به صورت تئوری و تجربی مورد بررسی قرار گرفته است [۹–۱۳]. نانوذرات اکسید مس به عنوان گزینه مناسب برای درمان مطرح هستند. افزون بر موارد بالا، به تازگی اختراع لیزرهای فیبر قفل شده مد آلاییده به تولیم گزارش شده است که از لایه نازک مس به عنوان جاذب اشباع-

از دیگر کاربردهای لایه نازک مس میتوان به جاذب نور خورشید و نیز بهعنوان یک زیرلایه مناسب برای لایه نشانی مواد دیگر مانند گرافن اشاره کرد که در پژوهشهای اخیر مورد توجه قرار گرفتهاند [10–۱۹].

با توجه به موارد بالا، لایههای نازک مس بسیار حائز اهمیت و کاربردی هستند و دستیابی به اطلاعات مناسب در مورد این لایه-های نازک میتواند منجر به رهیافت مناسب برای دستیابی به لیزرها، حسگرها و شرایط درمان مناسب تر شود. لایهنشانی فیزیکی از فاز بخار (PVD) یکی از روشهای متداول برای ایجاد لایههای نازک مس به شمار میرود. این لایهها را میتوان با انجام عملیات پس از/ درحین لایهنشانی (مانند بازپخت، بمباران یونی و ..) به نانوساختارهای موردنظر نیز تبدیل کرد[۱۹]. روش تبخیر حرارتی به دلیل سادگی نسبی، کم هزینه بودن نسبت به فلزی مناسب است[۲۰]. در این روش ماده مورد نظر به عنوان فلزی مناسب است[۲۰]. در این روش ماده مورد نظر به عنوان پشمه یا منبع در محفظه خلاً با اعمال جریان الکتریکی یا باریکه الکترونی تبخیر شده و بخارات حاصل در اثر اختلاف فشار به سمت زیرلایه گسیل میشوند تا در نهایت یک لایه جامد نازک

بر زیرلایه که در فاصله مشخصی از چشمه ثابت شده است، تشکیل شود. فاصله بین محل قرار گرفتن زیرلایه و چشمه مس پارامتر مهمی است که میتواند بر ویژگیهای لایه نازکِ مس ایجاد شده تاثیر بگذارد و حتی انتخاب نامناسب آن میتواند باعث ایجاد لایه با کیفیت نامطلوب و یا مقدار بسیار پایین لایهنشانی شود. روشهای تجربی و نظری میتوانند برای بررسی تاثیر این پارامتر اتخاذ شوند. بررسی نظری به دلیل قابلیت پیشبینی نتایج بدون صرف زمان و هزینه حائز اهمیت است.

روشهای متفاوتی برای شبیه سازی لایه نشانی لایه های نازک مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله این روش ها می توان به روش مونت کارلوی جنبشی (KMC)⁷، جانشانی اتم های تعدیل یافته (MEAM)⁷، دینامیک مولکولی (MD)⁴ و روش المان محدود (FEM)⁶ اشاره کرد [۲۱–۲۴].

در این مقاله، فرایند لایهنشانی لایه نازک مس با استفاده از روش تبخیر حرارتی شبیهسازی و برای نخستین بار تاثیر فاصله چشمه تا محل زیرلایه به صورت تئوری مورد بررسی قرار گرفته است. ۲-تئوری

در فرایند لایهنشانی ضخامت لایههای نازک ایجاد شده h_{film} با زمان افزایش مییابد. تغییرات زمانی ضخامت لایه نازک مس برابراست با[۲۵]:

$$\frac{dh_{film}}{dt} = \frac{M_n G}{N_A \rho_{film}} \tag{1}$$

که در اینجا N_A چگالی لایه نازک، M_n جرم مولی، N_A عدد اتمی مس و G شار بخار مولکول در طی لایهنشانی به روش تبخیر حرارتی است که با رابطه (۲) محاسبه می شود:

$$G = -\int_{S'} \frac{J'(n.r)(n'.r)}{\pi r^4} dS'$$
 (7)

$$P = -\int_{S'} \frac{J'(n.r)^2(n'.r)}{\pi r^5} \frac{M_n}{N_A} \langle C'_{3D} \rangle dS' + \frac{2JM_n}{3N_A}$$
(Y)

² Kinetic Monte Carlo

³ Modified embedded-atom method

⁴ Molecular dynamics

⁵ Finite element method

که در اینجا:

$$\left\langle C_{3D}'\right\rangle = \sqrt{\frac{9\pi RT'}{8M_n}} \tag{(f)}$$

چگالی تعداد n نیز در طی این فرایند با رابطه زیر محاسبه میشود:

$$n = -\int_{S'} \frac{J'(n.r)}{\pi r^5} \left\langle \frac{1}{C'_{3D}} \right\rangle dS' + 2 \left\langle \frac{1}{C'_{3D}} \right\rangle J \tag{(a)}$$

که در اینجا:

$$\left\langle \frac{1}{C'_{3D}} \right\rangle = \sqrt{\frac{\pi M_n}{8RT'}} \tag{8}$$

شارگرمایی Q نیز برابر است با :

$$Q = -\int_{S'} \frac{J'(n \cdot r)(n' \cdot r)}{\pi r^4} \frac{M_n}{N_A} \langle C_{3D}^{\prime 2} \rangle dS' - \frac{1}{2} \frac{M_n}{N_A} \langle C_{3D}^2 \rangle$$
(Y)
Solution:
Solution:

$$\left\langle C_{3D}^{\prime 2} \right\rangle = \sqrt{\frac{4RT^{\prime}}{8M_n}} \tag{A}$$

در شکل ۱ محفظه طراحی شده برای لایهنشانی تبخیر حرارتی نشان داده شده است. زیرلایه بر نگهدارندهای با فاصله جدایی d از چشمه قرار گرفته است.

برای دستیابی به اطلاعات مناسب در مورد تاثیر فاصله چشمه تا محل زیرلایه بر فرایند لایهنشانی به روش PVD و ضخامت لایه نازک مس باید معادلات حاکم بر مسئله به همراه شرایط مرزی و اولیه حل شوند. با توجه به اینکه هدف این مقاله بررسی تاثیر فاصله چشمه تا محل زیر لایه بر ضخامت و یکنواختی لایه نازک مس است، بنابراین مقادیر متفاوت فاصله چشمه تا محل زیر لایه شامل ۱۳، ۱۸، ۲۳، ۲۸ و ۳۳ سانتیمتر در شبیه سازی در زیر لایه در هر مرحله یکسان در نظر گرفته شده است. هندسه به زیر لایه در شریه سازی که در تطابق با دستگاه موجود در آزمایشگاههای پژوهشی است، در شکل ۱ نشان داده شده است. مقادیر کمیتهای استفاده شده در محاسبات نیز در جدول ۱ گردآوری شده است.



شكل۱: هندسه و ساختار به كار رفته در شبیهسازیها.

به منظور شبیه سازی مش بندی نواحی متفاوت، متفاوت انتخاب شده است. این مش بندی در نواحی کوچک مثل سطح زیر لایه ریز تر و در نواحی بزرگتر مثل محفظه بزرگتر انتخاب شده است. نمایی از مش بندی در شکل ۲ نشان داده شده است. ریز کردن زیاد مش بندی باعث زمان طولانی محاسبات می شود. از طرفی انتخاب مقادیر بزرگ نیز منجر به کاهش دقت محاسبات می شود، بنابراین، انتخاب مناسب مش بندی الزامی است. در این شبیه سازی مش بندی های متغیر در نواحی متفاوت استفاده شده است تا دقت بالا ایجاد شود و از طرفی زمان محاسبه خیلی زیاد نشود.

جدول ۱: مقادیر کمیتهای به کار رفته در شبیهسازی.

	. •	دمای بخار در		
	ورن اکا	چگالی	فشار	دماي زيرلايه
نوع ماده	مولخونی (1م m/m)	(g/cm^3)	۱۰۰Pa	(K)
	(g1/1101)		(K)	
مس)Cu	83/22	٨/٩۶	١٨۵۴	۲۹۳/۱۵



شکل ۲: نمایی از مشبندی به کار رفته در شبیهسازی.

۳– نتایج و بحث

فاصله منبع تبخیر تا سطح زیرلایه *b* یکی از پارامترهای مهم و تاثیرگذار بر فرایند لایه نشانی به روش تبخیر حرارتی است و انتخاب نامناسب این فاصله میتواند منجر به نتایج جبران ناپذیری مثل نایکنواختی بیش از حد لایه نازک و یا بازده پایین شود، بنابراین در این مقاله به بررسی تاثیر فاصله چشمه تا محل زیرلایه پرداخته شده است. برای این منظور، ساختارهایی با فواصل متفاوت چشمه تا محل زیر لایه ۱۳، ۱۸، ۲۳، ۲۸ و ۳۳ سانتیمتر در شبیه سازی در نظر گرفته شده است.

شکل ۳ نمودار توزیع فشار بخار در کل محفظه مربوط به ساختاری با فاصله چشمه تا زیرلایه d=۲۸cm در زمان ۱۲۰۶ را نشان میدهد. همانطور که مشاهده میکنید، بیشترین فشار در محل زیرلایه است و فشار در سایر سطوح بسیار ناچیز و با تقریب خوبی قابل صرفنظر کردن است.



شکل ۳: نمودار توزیع فشار درمحفظه و به ازای فاصله چشمه تا زیرلایه و زمان ۱۲۰ ثانیه.

به منظور بررسی دقیق تر در شکلهای ۴-الف تا ۴-ه نمودارهای توزیع فشار بخار وارد بر لایه در زمان ۲۰ ۱۲۰ برای پنج ساختار متفاوت به ازای ۳۳۵۳، ۲۸، ۳۲، ۱۸، ۳۳= *d* نشان داده شده است. همانطور که از این شکل دیده می شود، توزیع فشار بر لایه همواره به صورت متقارن بوده و در مرکز بیشترین مقدار خود را دارد. همچنین، بیشینه فشار بخار مس با افزایش فاصله چشمه تا زیرلایه از ۱۳ تا ۳۳ سانتیمتر، از Pa^{۲۰}-۱۰×۶ تا P^{۳-۱۰}×۸۰





نمودارهای توزیع ضخامت لایه نازک در سطوح متفاوت ساختارهایی با ۲۳۰۵، ۲۸، ۲۳ ها ط=۱۳ پس از ۱۲۰۶در شکلهای ۵ نشان داده شده است. بیشترین ضخامت لایه در تمام ساختارها بر زیرلایه ایجاد شده است، اما در هر حال

ضخامت این لایههای نازک به شدت تابع فاصله چشمه تا محل زیرلایه است. به طوریکه افزایش فاصله چشمه تا زیرلایه از ۱۳ تا ۳۳ سانتیمتر منجر به کاهش بیشینه ضخامت لایه نازک از اس۳ سانتیمتر منجر به کاهش بیشینه ضخامت لایه نازک از افزایش شار ذرات بخار مس با کاهش فاصله b میشود. نکته افزایش شار ذرات بخار مس با کاهش فاصله b میشود. نکته حائز اهمیت دیگر ایجاد ضخامت قابل توجه لایه بر سطح دیواره جانبی به ازای ۲۸cm (یجاد ضخامت قابل توجه لایه بر سطح دیواره شرایط ۲۸cm (یاکه است. در حالیکه، این ضخامت لایه شرایط ۲۰cm این ضخامت لایه برایت بیشترین ضخامت لایه تایجاد شده بر زیرلایه نیز در ۲۰cm مشاهده میشود. با توجه به مطالب بالا فاصله چشمه تا محل زیرلایه پارامتر هندسی تاثیرگذاری است که نه تنها ضخامت لایه نازک را تحت تاثیر قرار میدهد بلکه عامل موثری بر ایجاد لایه نازک در سطوح جانبی است و بازده فرایند لایهنشانی را تحت تاثیر خود قرار میدهد.



در شکل ۶ برای درک بهتر تاثیر b به عنوان پارامتر مهم هندسی بر لایه نازک، نمودارهای توزیع ضخامت لایه نازک در محل زیرلایه پس از ۱۲۰۶ برای ساختارهای شکل ۵ نشان داده شده است. نتایج نشان می دهد که ضخامت لایه نازک با افزایش b به طور قابل توجهی کاهش یافته است. با این وجود در تمامی ساختارها توزیع ضخامت لایه متقارن است و بیشترین ضخامت لایه در مرکز زیرلایه قرار داشته و با افزایش فاصله از مرکز این ضخامت کاهش می یابد. البته روند کاهش ضخامت در ساختارهای متفاوت متفاوت است و نیاز به بررسی دقیق تر دارد. برای این منظور نمودار سه بعدی توزیع ضخامت این ساختارها در زمان ۱۲۰۶ در شکل ۷ نشان داده شده است و برازش انجام شده موید مناسب بودن تابع گاوسی (۹) است:



شکل ۶۰ نمودارهای توزیع ضخامت لایه مس تشکیل شده بر روی زیرلایه در زمان ۱۲۰۶ به ازای فاصله بین چشمه تا محل زیرلایه الف) ۱۳C۳، ب)۱۸cm، ج) ۲۸cm، د) ۲۸cm و ۵۰۳۳.

شکل ۵: نمودارهای توزیع ضخامت لایه ایجاد شده در زمان ۱۲۰۶ در کل محفظه و روی زیرلایه به ازای فواصل متفاوت چشمه تا محل زیرلایه الف) ۱۳C۳، ب) ۱۸cm، ج) ۲۳cm، د) ۲۸cm و ه)۳۳cm.

$$z = z_0 + A \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x - x_c}{w_1}\right)^2 - \frac{1}{2}\left(\frac{y - y_c}{w_2}\right)^2\right] \quad (9)$$

بررسی FWHM یا پهنای ضخامت لایه ایجاد شده برای ساختارهای متفاوت نشان میدهد که افزایش فاصله چشمه تا زیرلایه در گستره ۱۳ تا ۳۳ سانتیمتر منجر به افزایش FWHM ضخامت لایه نازک از ۵۶/۲ mm ۱۹۹/۷ میشود که این تغییر چشمگیر نشان دهنده اهمیت زیاد انتخاب درست این کمیت یعنی فاصله چشمه تا زیرلایه است. هرچه این پهنای تابع بیشتر باشد، لایه بهدست آمده دارای ضخامت یکنواخت تر و بنابراین مطلوب تر است.



شکل ۷: نمودارهای سه بعدی توزیع ضخامت لایه نازک مس در زمان ۱۲۰۶ به ازای فاصله بین چشمه تا محل زیرلایه ۳۵ ۳۳، ۲۸، ۲۳، ۱۸، ۵۳=d

با توجه به نتایج به دست آمده فاصله چشمه تا محل زیرلایه b بر روی دو کمیت مهم لایهنشانی یعنی FWHM و نرخ لایهنشانی بسیار تاثیرگذار است. افزایش این فاصله منجر به افزایش FWHM و کاهش مقدار لایهنشانی می شود. بنابراین، انتخاب مناسب این کمیت با توجه به کاربرد و اهمیت لایه نازک بسیار مهم است. در شکل ۸ نمودار FWHM و نرخ لایهنشانی بر مهم است. در شکل ۸ نمودار FWHM و نرخ لایهنشانی بر مهم تابع نمایی با دقت بالا (۹۹/۰ \leq R) به این نمودارها برازش تابع نمایی با دقت بالا (۲۹۹/۰) به این نمودارها نشان می دهد که رابطه FWHM و نرخ لایهنشانی . (Dep. با فاصله بین چشمه تا محل زیرلایه له به صورت زیر است:

$$FWHM = -221.70 \exp(-d/37.74) + 212.95$$
 (1.)

$$Dep.Rate = 23.03 \exp(-d/8.36) + 0.70$$
 (11)



شکل ۸: تغییرات FWHM تابع توزیع ضخامت لایه و نرخ لایه نشانی برحسب فاصله چشمه تا زیر لایه.

d این روابط عملا امکان انتخاب مناسب فاصله چشمه تا زیرلایه d را فراهم می کنند. به طور مثال، در موارد کاربردهای متداول که حساسیت شدیدی در مورد یکنواختی ضخامت لایه نازک وجود ندارد، گستره فاصله چشمه تا زیرلایه ۲۰ تا ۲۵ سانتیمتر میتواند مناسب باشد و اگر ساختارهای با ضخامت یکنواخت ر مورد نظر باشد باید cm داد شود.

تحول زمانی ضخامت لایههای نازک نیز عامل مهمی است که تاکنون در این مقاله به آن به طور کامل پرداخته نشده است. در شکل ۹ نمودار تحول زمانی ضخامت لایههای ایجاد شده به ازای *d* های شکل ۷ آورده شده است. همانطور که ملاحظه می شود ضخامت لایههای نازک مربوط به فواصل متفاوت در هر زمان متفاوت است و در تمام زمانها ضخامت لایه ایجاد شده به ازای d=۱۳cm

مراجع

- A. Sharma, A. K. Goyal, and G. Rath, "Recent advances in metal nanoparticles in cancer therapy," Journal of drug targeting, 26, 617-632, 2018.
- [2] R. Chakraborty and T. Basu, "Metallic copper nanoparticles induce apoptosis in a human skin melanoma A-375 cell line," Nanotechnology, 28, 105101-105111, 2017.
- [3] S. Kamble et al., "Evaluation of curcumin capped copper nanoparticles as possible inhibitors of human breast cancer cells and angiogenesis: a comparative study with native curcumin," AAPS PharmSciTech, 17, 1030-1041, 2016.
- [4] A.C. Anselmo and S. Mitragotri, "A review of clinical translation of inorganic nanoparticles," The AAPS journal, 17, 1041-1054, 2015.
- [5] J.K. Kim et al., "Therapeutic application of metallic nanoparticles combined with particle-induced x-ray emission effect," Nanotechnology, 21, 425102-425208, 2010.
- [6] Kruk et al., "Nanocomposite T. multifunctional polyelectrolyte thin films with nanoparticles copper as the antimicrobial coatings," Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 181, 112-118, 2019.
- [7] X. Huang, A. B. Schubert, J. D. Chrisman, and N. S. Zacharia, "Formation and tunable disassembly of polyelectrolyte–Cu2+ layerby-layer complex film," Langmuir, 29, 12959-12968, 2013.
- [8] E. Korzeniewska, A. Szczęsny, J. Józwik, and A. Tofil, "Computer measurement of the friction of thin metal structure created in PVD technology on the flexible substrate," in MATEC Web of Conferences, 252, 09005:-09015,2019.
- [9] M. Aliannezhadi, M. Minbashi, and V.V. Tuchin, "Effect of laser intensity and exposure time on photothermal therapy with nanoparticles heated by a 793-nm diode laser and tissue optical clearing," Quantum Electronics, 48, 559-567, 2018.
- [10] H. Ahmadian, F.S. Tehrani, and M. Aliannezhadi, "Hydrothermal synthesis and



شکل ۹: نمودار تحول زمانی ضخامت لایههای نازک مس به ازای فواصل متفاوت چشمه تا زیرلایه.

۴- نتیجهگیری

لایههای نازک مس به طور گسترده در پزشکی و صنعت کاربرد دارند. از جمله کاربردهای این لایههای نازک میتوان به کاربرد در حسگرهای امنیتی، حسگرهای پزشکی و حسگرهایی که دما و یارامترهای حیاتی بدن را چک میکنند، صفحات خورشیدی، لیزرهای قفل شده مد، درمان سرطان و اشاره کرد. در این مقاله، فرایند ایجاد لایه نازک مس با روش تبخیر حرارتی به صورت نظری مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر فاصله بین چشمه مس و زیرلایه به عنوان یک پارامتر مهم بر لایه نازک تشکیل شده، مطالعه شد. نتایج شبیهسازیها نشان داد که فشار بخار مس وارد بر سطح زیرلایه با افزایش فاصله چشمه تا زیر لایه d به شكل قابل توجهي كاهش مي يابد. همچنين، بررسي ضخامت لایههای نازک در دیوارهها و نیز زیر لایه به شدت به فاصه چشمه و زیرلایه بستگی دارد و با افزایش این فاصله ضخامت لایه در محل زیرلایه و دیوارههای محفظه به ترتیب کاهش و افزایش می یابد. در تمام ساختارها افزایش خطی ضخامت لایه با زمان مشاهده شد اما شیب این افزایش متفاوت است و این شیب يا به عبارتي مقدار لايهنشاني با افزايش اين فاصله به صورت نمایی کاهش می یابد. بنابراین افزایش این فاصله باعث کاهش بازده لايه نشاني خواهد شد. از طرفي، افزايش اين فاصله باعث افزایش FWHM یا به عبارتی یکنواختی بیشتر ضخامت لایه می شود. بنابراین با توجه به کاربرد لایه نازک مس می توان فاصله بهینه چشمه تا زیرلایه را انتخاب و فرایند لایهنشانی را انجام داد.

- [21] H.D. Espinosa and B. Prorok, "Size effects on the mechanical behavior of gold thin films," Journal of Materials Science, 38, 4125-4128, 2003.
- [22] C. Claassens, J. Terblans, M. Hoffman, and H. Swart, "Kinetic Monte Carlo simulation of monolayer gold film growth on a graphite substrate," Surface and Interface Analysis: An International Journal devoted to the development and application of techniques for the analysis of surfaces, interfaces and thin films, 37, 1021-1026, 2005.
- [23] E. Chason and A. F. Bower, "Kinetic Monte Carlo simulations of stress and morphology evolution in polycrystalline thin films," Journal of Applied Physics, 125, 115304-115314, 2019.
- [24] T. van Opstal and B. van der Linden, "Modeling of Chemical Vapor Deposition at the Pore-Scale Using Finite Cell Method," 2019.
- [25] M. Ohring, Materials science of thin films. 2001.

characterization of WO₃ nanostructures: effects of capping agent and pH," Materials Research Express, 6, 1050210-1050217, 2019.

- [11] S. Soni and R. K. Sinha, "Tumor blood perfusion-based requirement of nanoparticle dose-loadings for plasmonic photothermal therapy," Nanomedicine, 14, 1841-1855, 2019.
- [12] M. Aliannezhadi, S. Amini, M. Taghizadeh, and M. Heidari, "The Effect of Light Fluence Rate on Photodynamic Therapy," (in eng), Laser in Medicine, Research 16, 26-18, 2019.
- [13] M. Aliannezhadi, A.H. Mollazadeh, and M. Minbashi, "The effect of nano particles and laser intensity on cancer therapy and Tissue temperature variations after irradiation," (in eng), Laser in Medicine, 13, 11-20, 2018.
- [14] A. Muhammad, M. Ahmad, R. Zakaria, P. Yupapin, S. Harun, and M. Yasin, "Modelocked thulium doped fibre laser with copper thin film saturable absorber," Journal of Modern Optics, 14, 1-5, 2019.
- [15] M.J. Kadhim, K.A. Sukkar, and A.S. Abbas, "Copper Thin Film Deposited By PVD on Aluminum AA4015 Substrate for Thermal Solar Application," in IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 518, 032048-032055,2019..
- [16] C.E. Kennedy, "Review of mid-to hightemperature solar selective absorber materials," National Renewable Energy Lab., 13, 114-120, 2002.
- [17] X. Xu et al., "Ultrafast epitaxial growth of metre-sized single-crystal graphene on industrial Cu foil," Science bulletin, 62, 1074-1080, 2017.
- [18] T. Ma, H. Ariga, S. Takakusagi, and K. Asakura, "Smooth epitaxial copper film on sapphire surface suitable for high quality graphene growth," Thin Solid Films, 646, 12-16, 2018.
- [19] P.A. Pivovarov et al., "Crystallization of Thin Copper Films on Silica Substrate for Graphene Growth," physica status solidi (b), 16, 1800685-1800691, 2019.
- [20] A. Lakhtakia and R.J. Martín-Palma, Engineered biomimicry. Newnes, 18, 112-120, 2013.



Theoretical study on the effect of source-to-substrate distance on copper thin film deposited by thermal evaporation technique

J. Alipoor Zardkoohi, F. Shariatmadar Tehrani*, Maryam Aliannezhadi

Faculty of Physics, Semnan University, Semnan, Iran.

Abstract: Copper thin films are widely used in security sensors, medical sensors, solar panels, mode locked laser, cancer treatment, and so on. Thermal evaporation is a common technique for deposition of copper thin films. The distance between the copper source and the substrate is an important parameter that has not been investigated yet. Therefore, the effect of this parameter on the process of copper thin film deposition by thermal evaporation is investigated theoretically in this paper. The results showed that the copper vapor pressure on the substrate surface, the deposition rate and the thickness of the thin layer decreased with increasing this distance, whereas the uniformity of the film thickness improved with increasing the distance. The deposition rate decreased from 5.57nm/s to 1.12 nm/s and the thickness uniformity increases from 56 nm to 120 nm with increasing distance from 13 cm to 33 cm. Also, the dependence of thickness uniformity and deposition rate on the source-to-substrate distance was presented to select the appropriate distance according to the application of the thin layer.

Keywords: Copper thin film, Thermal evaporation, Simulation, Deposition rate, Physical vapor deposition